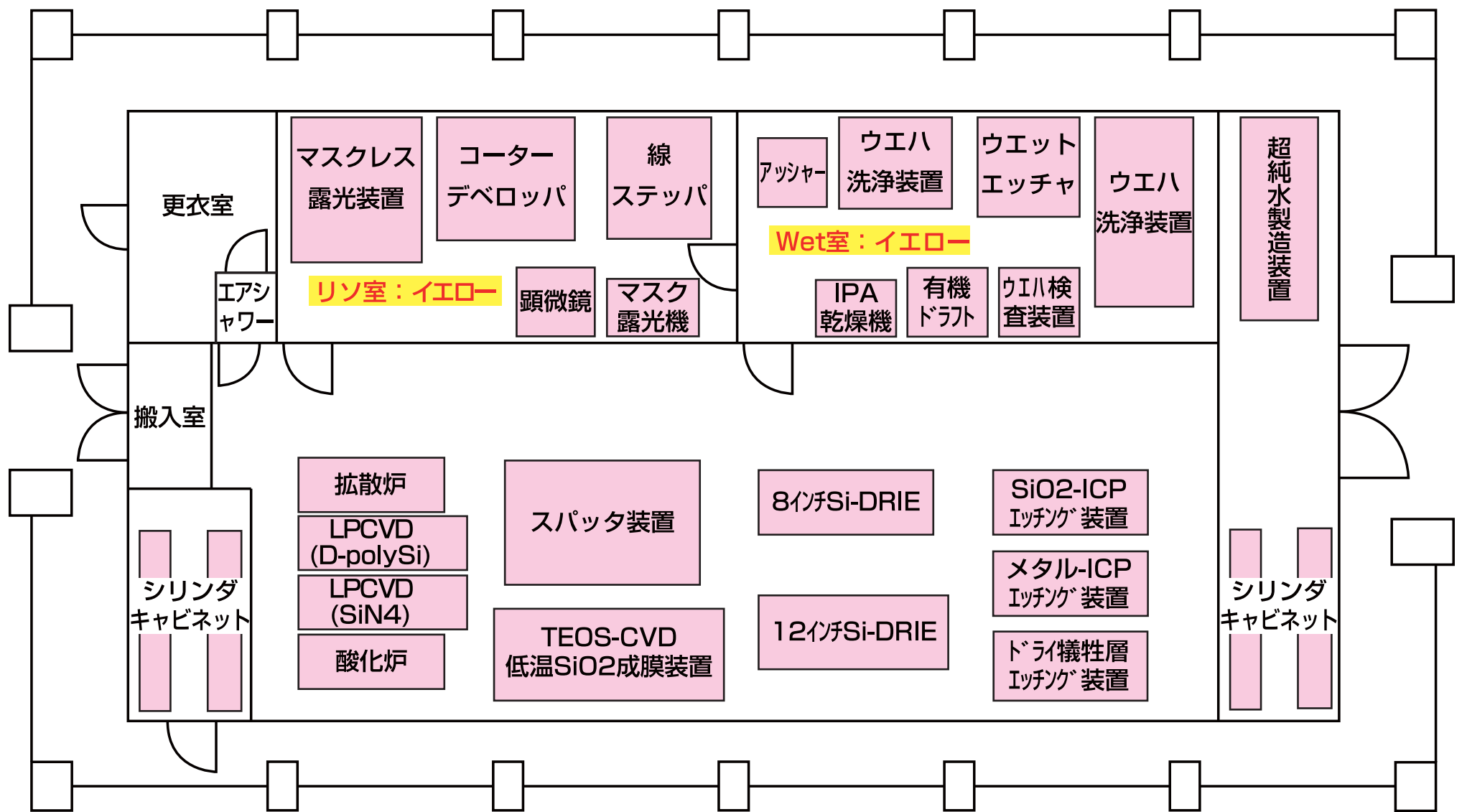
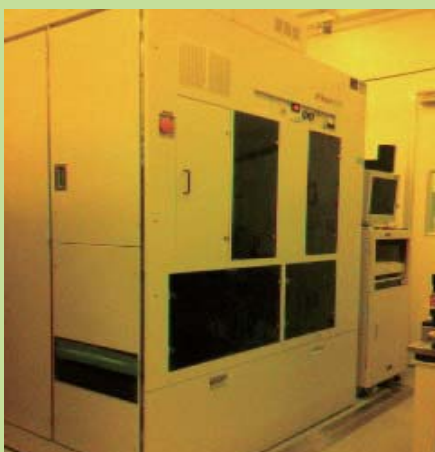


グリーンイノベーションを牽引するGデバイス

最先端 8 インチ MEMS ライン (TKB812F) の構築



TKB812F設備配置図(約350m²、クラス1000)



i線 - ステッパー
8インチ



シリコン深掘りDRIE
8、12インチ



ドライ犠牲層エッチャー
8インチ



TEOS-CVD装置
8、12インチ

MEMSライン主要設備